

Judul:

Analisis penskalaan lateral dan vertikal dari rancangan silicon germanium heterojunction bipolar transistor (HBT'S SIGE) =Lateral and vertical scaling analysis of the silicon germanium heterojunction bipolar transistor's design (HBT's SiGe)

Pengarang/Penulis:

Ahmad Tossin Alamsyah, author

Subjek:

Silicon; Germanium; Bipolar transistors

Nomor Panggil:

D999

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)